

の電気抵抗, ホール抵抗, 磁気抵抗の測定を行った。

PdNi, PtNiで計8種類の合金を製作し, Pure Pdも参考に測定した。特に磁気変態をおこす組成の近傍で, 測定を行い, 磁気変態に伴う輸送現象の変化に注目している。

測定は0~50 KGの磁場範囲で行い, 温度は基本的に42 K, 77 K, 室温で行った。

その結果, PdNi合金では異常ホール係数の符号が組成によっても, 温度によっても変化する事が測定された。

また, 高磁場で磁場に比例する磁気抵抗を測定した。

以上の実験結果を従来の理論と比較するとともに, 強磁性的なdバンドを用いて定性的に考察した。

## 12. PdPb<sub>2</sub>におけるdHvA効果

杉山 康成

金属間化合物では完全な結晶を得ることがむずかしく, そのため, 電子構造の解析も一部の化合物に限られている。

今回の研究では, C16構造を持つ金属間化合物PdPb<sub>2</sub>のフェルミ面の解析を行うために, 7 Tまでの磁場中で, de Hass-van Alphen効果の測定を行った。測定には, 磁場変調法を用い, そのための測定装置のいくつかを製作した。測定における, 磁場の方位は, 試料の(001)面内に限られたが, 周波数2200 T以下の8つのブランチが観測され, それらは, 1-OPWによって求められたフェルミ面と比較された。各ブランチの周波数及び振幅のふるまいを理解するために, スピン分離の効果, 中心以外に断面積の極値を持つフェルミ面のシート, さらに, オープン軌道の存在の可能性も考慮し, 5つのフェルミ面のシートを7つの周波数ブランチに対応づけた。

しかし, フェルミ面全体の形をつかむためには, 今回観測されなかった, より高い周波数の信号を検出する必要がある。